

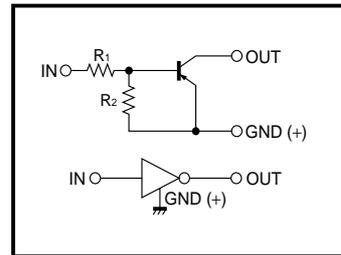
デジタルトランジスタ (抵抗内蔵トランジスタ)

DTA115EM / DTA115EE / DTA115EUA / DTA115EKA / DTA115ESA

●特長

- 1) バイアス用の抵抗を内蔵しているため、入力側の外付け抵抗なしでインバータ回路が構成できる。(等価回路図参照)
- 2) バイアス用の抵抗は薄膜により構成し完全にアイソレートしているため、入力を正にバイアスでき、寄生効果もほとんど生じない。
- 3) ON/OFF 条件の設定だけで動作するため、機器の設計が容易に行える。
- 4) 実装密度の向上を図ることができる。

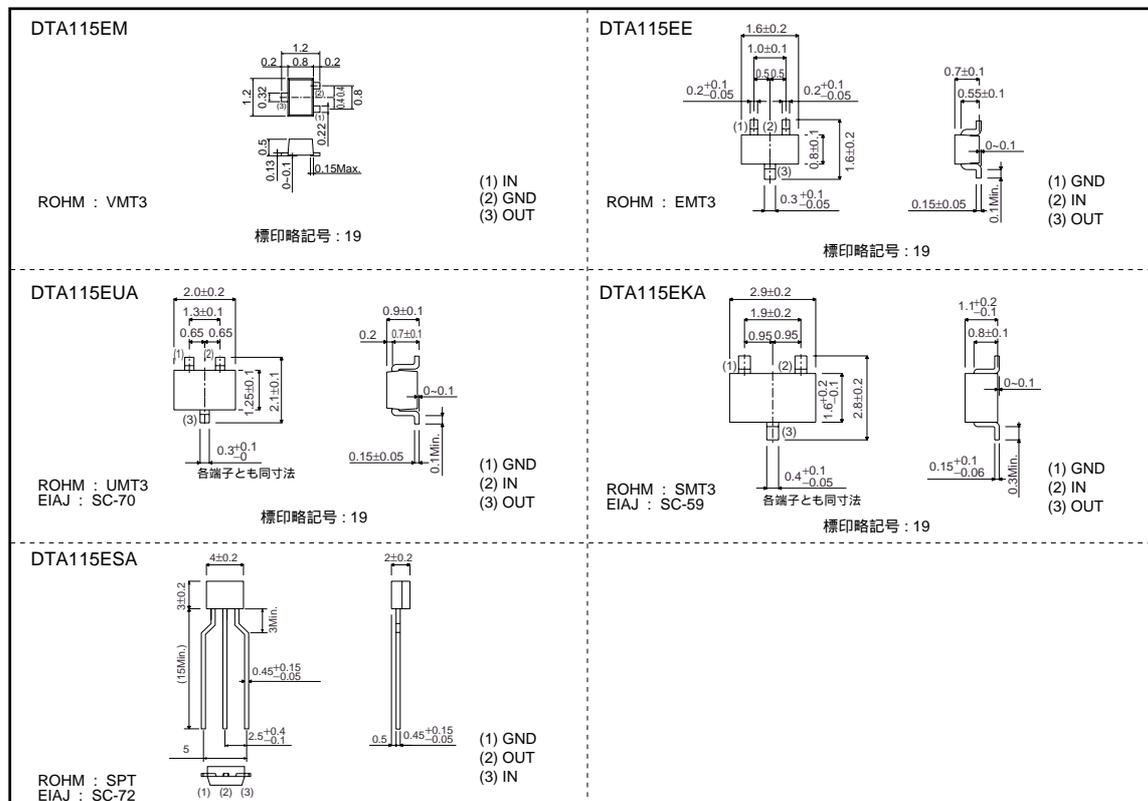
●内部等価回路図



●構造

PNP デジタルトランジスタ (抵抗内蔵トランジスタ)

●外形寸法図 (Units : mm)



DTA115EM / DTA115EE / DTA115EUA / トランジスタ DTA115EKA / DTA115ESA

●絶対最大定格 (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
電源電圧	V _{cc}	-50	V
入力電圧	V _i	-40~+10	V
出力電流	I _o	-20	mA
	I _{c(Max.)}	-100	
許容損失	DTA115EM / DTA115EE	150	mW
	DTA115EUA / DTA115EKA	200	
	DTA115ESA	300	
接合部温度	T _J	150	°C
保存温度範囲	T _{stg}	-55~+150	°C

●電気的特性 (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
入力電圧	V _{i(off)}	-	-	-0.5	V	V _{cc} =-5V, I _o =-100μA
	V _{i(on)}	-3	-	-		V _o =-0.3V, I _o =-1mA
出力電圧	V _{o(on)}	-	-0.1	-0.3	V	I _o =-5mA, I _i =-0.25mA
入力電流	I _i	-	-	-0.15	mA	V _i =-5V
出力電流	I _{o(off)}	-	-	-0.5	μA	V _{cc} =-50V, V _i =0V
直流電流増幅率	G _i	82	-	-	-	I _o =-5mA, V _o =-5V
入力抵抗	R ₁	70	100	130	kΩ	-
抵抗比率	R ₂ /R ₁	0.8	1	1.2	-	-
利得帯域幅積	f _r	-	250	-	MHz	V _{ce} =10V, I _e =-5mA, f=100MHz *

*構成トランジスタの特性です。

●パッケージ、標印及び包装仕様

Type	DTA115EM	DTA115EE	DTA115EUA	DTA115EKA	DTA115ESA
パッケージ名	VMT3	EMT3	UMT3	SMT3	SPT
標印	19	19	19	19	-
包装記号	T2L	TL	T106	T146	TP
基本発注単位 (個)	8000	3000	3000	3000	5000